

# 2SC1060, 2SC1061

シリコン NPN 三重拡散形

低周波電力増幅用

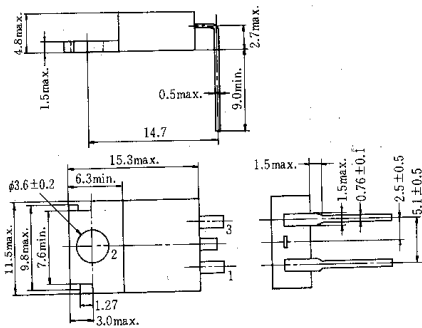
2SA670, 2SA671 とコンプリメンタリペア

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

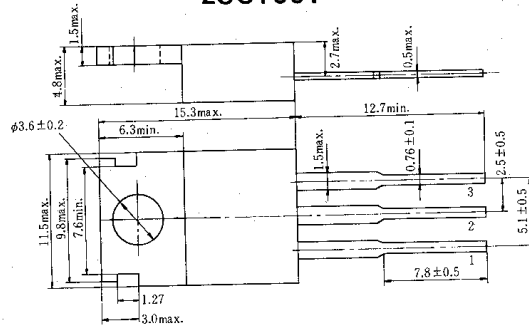
Complementary pair with 2SA670 and 2SA671

2SC1060



(JEDEC TO-220AA)

2SC1061



(JEDEC TO-220AB)

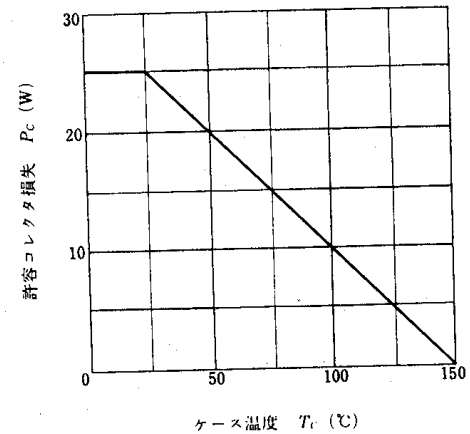
1. ベース: Base
2. コレクタ: Collector (フランジ) (Flange)
3. エミッタ: Emitter (Dimensions in mm)

## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SC1060, 2SC1061	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	50	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	50	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	4	V
コレクタ電流	$I_C$	3	A
許容コレクタ損失	$P_C^*$	25	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$

\*  $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値  
\* Value at  $T_C=25^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=5\text{mA}, I_E=0$	50	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	50	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=5\text{mA}, I_C=0$	4	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$	—	—	100	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=1\text{A}$	35	—	320	
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=0.1\text{A}$	35	—	—	
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=1\text{A}$	—	0.85	1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.2\text{A}$	—	0.5	1.0	V
2次破壊電流	$I_M$	$V_{CE}=40\text{V}, f=50\text{Hz}$ (Half Wave)	2.0	—	—	A
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=0.5\text{A}$	—	8	—	MHz

\* 2SC1060, 2SC1061は $h_{FE}$ の値により下記のように4区分し、現品に表示してあります。  
\* The 2SC1060 and 2SC1061 are grouped by  $h_{FE}$  as follows.

A	B	C	D
35~70	60~120	100~200	160~320